002

AUG 2 0 2002

File No. 28-1154

Dispatch No. 133432

Dispatch Date: May 21, 2002

1/2

NOTIFICATION OF REASONS FOR REJECTION

Patent Application No.:

Patent Application No. 122507 of Heisei 11 [1999]

Draft Date:

April 24, 2002

Patent Office Examiner:

Shin'ichi Yamazaki

9174 5W00

Patent Applicant:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Applicable Sections:

Section 29 (2)

The present application should be rejected for the following reasons. If you have an opinion concerning this, please submit a statement of opinion within 60 days from the date of dispatch of this notification.

Reasons

The inventions claimed in the following claims of the present application are inventions that could easily have been invented prior to the filing of the application by a person having an ordinary knowledge of the technical field to which the inventions belong on the basis of inventions described in the following publications, which were disseminated in Japan or in foreign countries prior to the filing of the application. Thus, in accordance with the provisions of Section 29 (2) of the Patent Law, these inventions cannot be patented.

Note (For cited references, etc., see the Table of Cited References, etc.)

- Claims 1 through 5
- Cited References, etc. 1 and 2
- Remarks

It is indicated in Cited Example 1 that the thicknesses of the IDT film and piezoelectric body are reduced by forming the IDT electrodes from a metal that has a density greater than that of the piezoelectric substrate and physically bombarding the IDT electrodes with ions. Furthermore, the manufacturing method in which a plurality of surface wave elements are formed on a single substrate and divided, etc., has always been universally known as described in Cited Example 2, for instance. Moreover, deciding which is performed first between the frequency adjustment process and division process is simply a design matter and can be determined by a person skilled in the art as desired.

If reasons for rejection are newly discovered, you will be notified of these reasons for rejection.

Table of Cited References, etc.

- 1. Japanese Patent Application Kokai No S61-020410
- 2. Japanese Patent Application Kokai No. H04-199906

Record of Results of Survey of Prior Art References

[Stamp: Usami, 5/22/02]

D03

Dispatch No. 133432

• Field surveyed:

IPC 7th Edition

H 03 H 3/10

DB Name

• Prior Art References:

Japanese Patent Application Kokai No. H07-273582

Japanese Patent Application Kokai No. H07-074573

Japanese Patent Application Kokai No. H10-284970

Japanese Patent Application Kokai No. H06-057451

Japanese Patent Application Kokai No. S54-156455

Japanese Patent Application Kokai No. S63-151103

Japanese Patent Application Kokai No. H04-196708

Japanese Patent Application Kokai No. S61-092011

This record of the results of a survey of prior art references does not constitute any reason for rejection.

2/2

整理番号 28-1154

発送番号 133432

30

発送日 平成14年 5月21日 1/ 2

拒絕理由通知書

特許出願の番号

平成11年 特許願 第122507号

起案日

平成14年 4月24日

特許庁審査官

山崎 慎一

9174 5W00

特許出願人

株式会社村田製作所 様

適用条文

第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見が あれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において 頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属 する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができた ものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができな い。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項
- . 1 ~ 5
- ·引用文献等 1.2
- ・備考

引用例1には、圧電基板よりも密度の大きい金属によってIDT電極を形成し、イオンを物理的に衝突させてIDT膜厚及び圧電体を減少させることが記載されている。なお、複数の表面波素子を1つの基板上に形成した上分割する等の製造方法は、例えば引用例2に記載されているように従来周知であり、また、周波数調整工程と分割工程との間でいずれを先に行うかは単なる設計的事項に過ぎず、当業者が任意に定めることができるものである。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引用文献等一覧

- 1. 特開昭 6 1 0 2 0 4 1 0 号公報
- 2. 特開平04-199906号公報



- ・調査した分野 I P C 第 7 版 H O 3 H 3 / 1 O D B 名
- ・先行技術文献

特開平07-273582号

特開平07-074573号

特開平10-284970号

特開平06-057451号

特開昭 5 4 - 1 5 6 4 5 5 号

特開昭63-151103号

特開平04-196708号

特開昭61-092011号

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。